
	<p><b>SI4100DY-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4100DY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 6.8A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4100DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 11838 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4100DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 6.8A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	11838 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 6.8A (Tc) 2.5W (Ta), 6W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 4.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	600pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4100DY-T1-GE3CT

SI4100DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4100DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4100DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4100DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4101DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 25.7A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4102DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4102DY</b> VISHAY SI4102DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4102DY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4100DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 6.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4100DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 6.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4100DY</b> VISHAY SI4100DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4101DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 25.7A 8SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

SI4004DY-T1-E3	SI4010-C2-GSR	SI4010-C2-GSR.	SI4010-C2-GT	SI4010DY
SI4101DY-T1-GE3	SI4010DY-T1-GE3	SI4012-C1001GTR	SI4021-A1-FTR	SI4022-A0-FTR
SI4022-A1-FTR	SI4030-A0-FM	SI4032-V2-FMR	SI4033-B2-FM	SI4048DY-T1-E3
SI4056DY	SI4056DY-T1-E3	SI4056SPG	SI4058DY	SI4090DY
SI4100BDDY-T1-GE3	SI4100DY	SI4100DY-T1-E3	SI4100DY-T1-E3	SI4100DY-T1-GE3
SI4102DY	SI4102DY-T1-E3	SI4102DY-T1-E3	SI4102DY-T1-GE3	SI4102DY-T1-GE3
SI4104DY-T1-GE3	SI4104DY-T1-GE3	SI4108DY-T1-GE3	SI4108DY-T1-GE3	SI4110DY-T1-GE3
SI4110DY-T1-GE3	SI4112-D-GM	SI4113-BMR	SI4114DY	SI4114DY-T1-E3
SI4114DY-T1-E3	SI4114DY-T1-GE3	SI4114DY-T1-GE3	SI4116DY	SI4116DY-T1-E3
SI4116DY-T1-E3	SI4116DY-T1-GE3	SI4116DY-T1-GE3	SI4122-BTR	SI4122-D-GMR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

